

# 2SD317, 2SD317A, 2SD318, 2SD318A

(2SD317, 2SD317A, 2SD318, 2SD318A : 保守品種 / MAINTENANCE)

## シリコン NPN 拡散接合メサ型 / Si NPN Diffused Junction Mesa

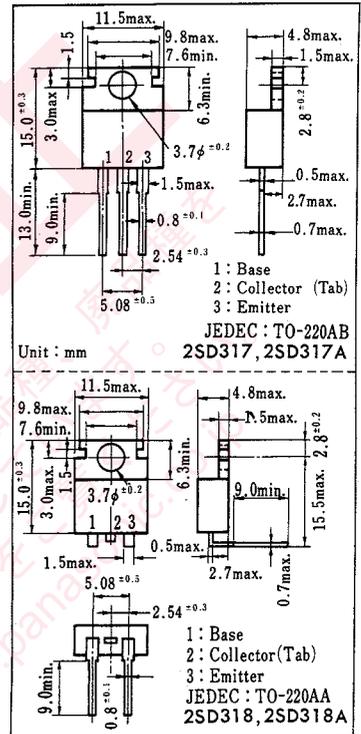
### 中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier

#### 特徴 / Features

- コレクタ損失  $P_C$  が大きい。 / Large collector dissipation
- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation
- 2SD318, 2SD318A はリードを整形し TO-66 タイプへの置換が可能です。 / With lead forming, fits to TO-66 socket.

#### 最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	60	V
2SD317/318 2SD317A/ 318A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	60	V
2SD317/318 2SD317A/ 318A		80	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	8	V
コレクタ電流	$I_C$	3	A
ベース電流	$I_B$	1	A
コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	25	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



#### 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	$I_C=0.2A, L=25mH$	60			V
2SD317/318 2SD317A/318A			80			
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20V, I_E=0$			30	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=8V, I_C=0$			1.0	mA
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=3V, I_C=0.1A$	40			
	$h_{FE2}^*$	$V_{CE}=3V, I_C=1A$	30	60	160	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=3V, I_C=1A$			1.4	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=0.4A$			1.0	V
シャ断周波数	$f_{\alpha e}$	$V_{CE}=10V, I_C=0.2A$		25		kHz

\*  $h_{FE2}$  ランク分類 /  $h_{FE2}$  Classifications

$h_{FE2}$	30~60	50~100	80~160
分類	Q	P	O